

CMT8100, CMT8101 高可靠性双向 I2C 隔离器

特性

- 高达 3750 / 5000 Vrms 的绝缘电压
- I2C 时钟速率：高达 2 MHz
- 电源电压：2.5 V 至 5.5 V
- 高 CMTI：150 kV/us
- 芯片级 ESD：HBM，±6 kV
- 高系统级 EMC 性能：
 - 增强的系统级 ESD、EFT、浪涌能力
- 隔离栅寿命：>40 年
- 低功耗：1.5mA/ch (1 Mbps)
- 低传播延时：<15 ns
- 工作温度：-40℃~125℃
- 符合 RoHS 标准封装：
 - SOIC-8 窄体
 - SOIC-16 宽体
- 安全认证
 - UL 认证：UL1577，3750 / 5000 Vrms，1 分钟
 - 符合 GB4943.1-2011 CQC 认证
 - CSA 组件，5A
 - DIN VDE V 0884-11:2017-01

应用

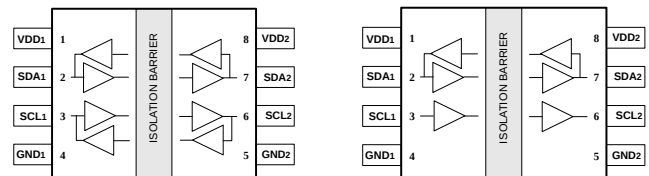
- 以太网供电
- 隔离式 I2C、SMBus 或 PMBus 接口
- I2C 电平转换
- 电池管理

描述

CMT8100, CMT8101 系列芯片为兼容 I2C 接口的高可靠性双向隔离器，符合 AEC-Q100 标准，UL1577 安规，支持多种电气隔离耐压（3.75 kVrms、5 kVrms）；同时以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射。CMT810x 的 I2C 时钟高达 2 MHz，共模瞬态抗干扰度(CMTI) 高达 150 kV/us。CMT810x 器件的宽电源电压支持直接连接大多数数字接口，平稳实现电平转换。其高系统级 EMC 性能增强了设备的可靠性和稳定性。

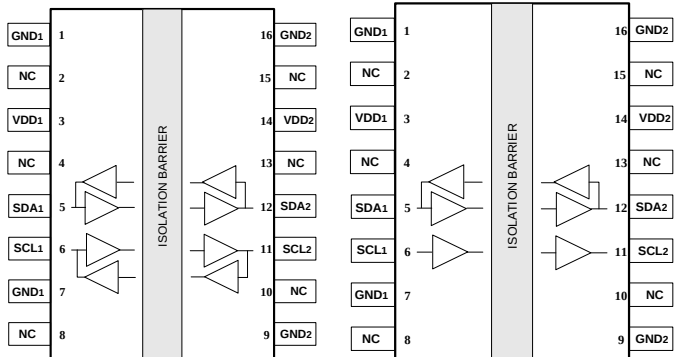
芯片订购信息

型号	封装	封装尺寸 (mm x mm)
CMT810x	NB(N) SOIC-8	4.9 x 3.9
	WB(W) SOIC-16	10.4 x 7.5
详见第 9 章节订购信息。		



CMT8100N SOIC8

CMT8101N SOIC8



CMT8100W SOIC16 宽体

CMT8101W SOIC16 宽体

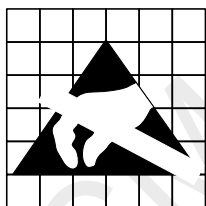
目录

1 绝对最大额定值	3
2 管脚描述	4
3 典型应用	6
3.1 典型应用原理图	6
3.2 PCB 布局指南	6
4 电气特性	7
4.1 电气特性	7
4.2 电源电流特性 - 5 V 电源	7
4.3 电源电流特性 - 3.3 V 电源	8
4.4 电源电流特性 - 2.5 V 电源	9
4.5 典型特性	10
4.6 参数测试电路	10
5 高压特性	12
5.1 隔离特性	12
5.2 DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01 隔离特性	12
5.3 安规认证	13
6 功能描述	15
6.1 功能概述	15
7 封装外形	17
7.1 CMT8100N/CMT8101N SOIC-8 窄体封装	17
7.2 CMT8100W/CMT8101W 宽体 SOIC-16 封装	18
8 顶部丝印	19
9 订购信息	20
10 文档变更记录	21
11 联系方式	22

1 绝对最大额定值

表 1. 绝对最大额定值^[1]

参数	符号	条件	最小	典型值	最大	单位
电源电压	VDD1, VDD2		-0.5		6.5	V
最大输入电压	SDA1, SDA2, SCL1, SCL2		-0.4		VDD+0.4 ^[1]	V
最大输入脉冲电压	SDA1, SDA2, SCL1, SCL2	脉冲宽度需小于 100ns, 占空比需小于 10%。	-0.8		VDD+0.8	V
瞬态共模抑制	CMTI				±150	kV/us
输出电流	I _o		-15		15	mA
最大浪涌抑制	VIOSM				5.3	kV
工作温度	T _{opr}		-40		125	°C
存储温度	T _{stg}		-40		150	°C
静电放电	HBM				±6000	V
	CDM				±2000	V
备注:						
[1]. 最大电压不得超过 6.5V。						



警告! ESD敏感器件. 对芯片进行操作的时候应注意做好ESD防范措施, 以免芯片的性能下降或者功能丧失。

2 管脚描述

CMT8100x, CMT8101x 均支持 SOIC-8 窄体和 SOIC-16 宽体封装，管脚信息如下。

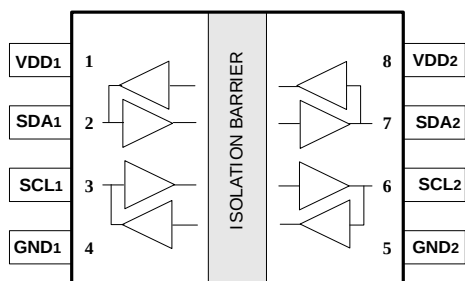


图 1. CMT8100N 管脚排列

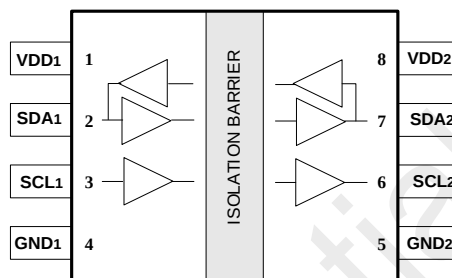


图 2. CMT8101N 管脚排列

表 2. CMT8100N/8101N 管脚描述

管脚号	管脚名称	I/O	功能说明
1	VDD ₁	-	隔离第一侧的电源输入。
2	SDA ₁	I/O	隔离第一侧串行数据输入/输出。
3	SCL ₁	I/O	隔离第一侧串行时钟输入/输出。
4	GND ₁	-	隔离第一侧的接地基准。
5	GND ₂	-	隔离第二侧的接地基准。
6	SCL ₂	I/O	隔离第二侧串行时钟输入/输出。
7	SDA ₂	I/O	隔离第二侧串行数据输入/输出。
8	VDD ₂	-	隔离第二侧电源输入。

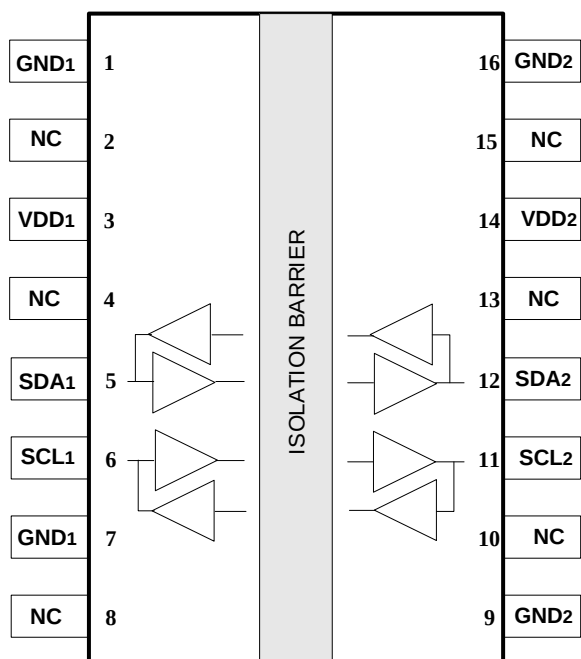


图 3. CMT8100W 管脚排列

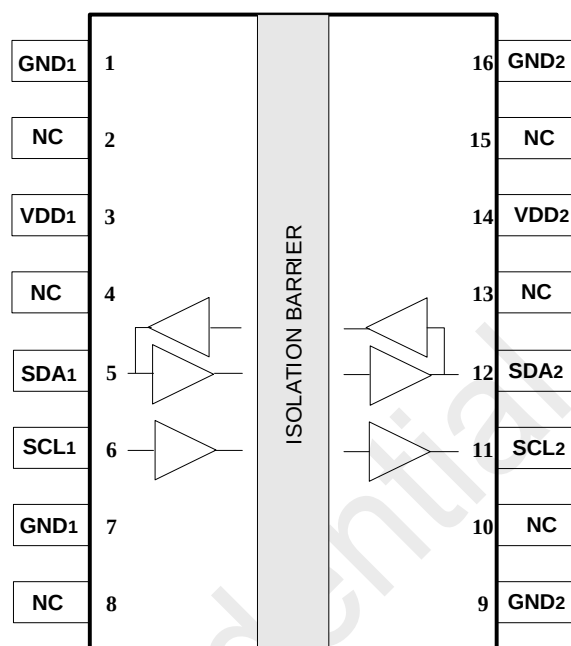


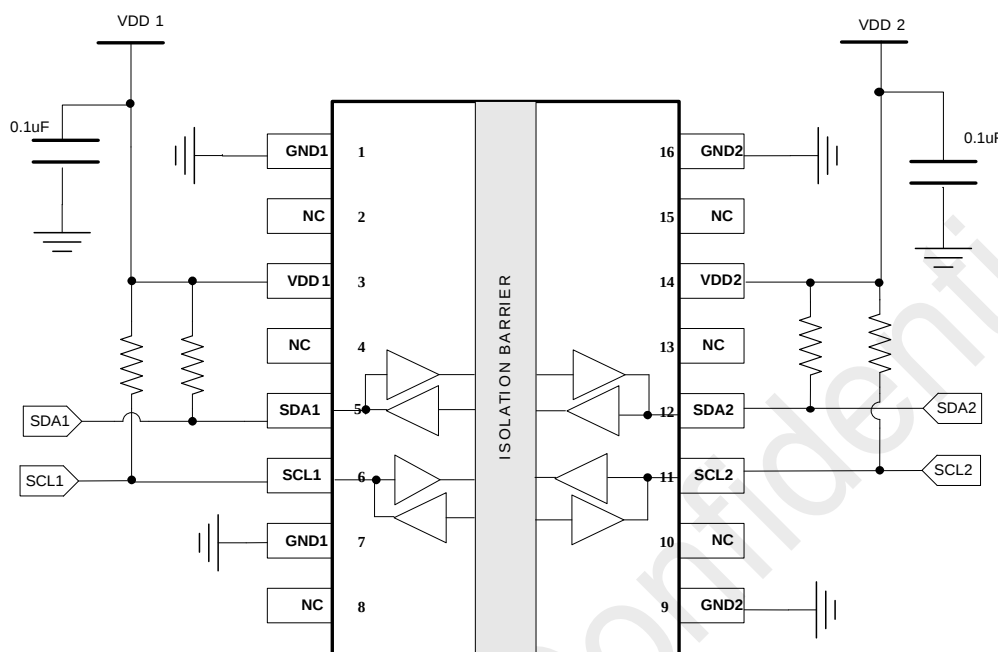
图 4. CMT8101W 管脚排列

表 3. CMT8100W/8101W 管脚描述

管脚号	管脚名称	I/O	功能说明
1	GND1	-	Ground 1, 隔离第一侧的接地基准。
2	NC	-	无连接。
3	VDD1	-	隔离第一侧的电源输入。
4	NC	-	无连接。
5	SDA1	I/O	隔离第一侧串行数据输入/输出。
6	SCL1	I/O	隔离第一侧串行时钟输入/输出。
7	GND1	I/O	Ground 1, 隔离第一侧的接地基准。
8	NC	-	无连接。
9	GND2	-	Ground 2, 隔离第二侧的接地基准。
10	NC	-	无连接。
11	SCL2	I/O	隔离第二侧串行时钟输入/输出。
12	SDA2	I/O	隔离第二侧串行数据输入/输出。
13	NC	-	无连接。
14	VDD2	-	隔离第二侧的电源输入。
15	NC	-	无连接。
16	GND2	-	Ground 2, 隔离第一侧的接地基准。

3 典型应用

3.1 典型应用原理图



3.2 PCB 布局指南

CMT810x 在 VDD1 和 GND1、VDD2 和 GND2 之间需要一个 $0.1\ \mu\text{F}$ 的旁路电容。电容器应尽可能靠近封装位置。如下图推荐 PCB 布局所示，确保芯片下方的空间无铺地、走线、焊盘、过孔。第 1 侧和第二侧总线均需上拉电阻，其电阻值取决于总线上 I2C 设备的数量。

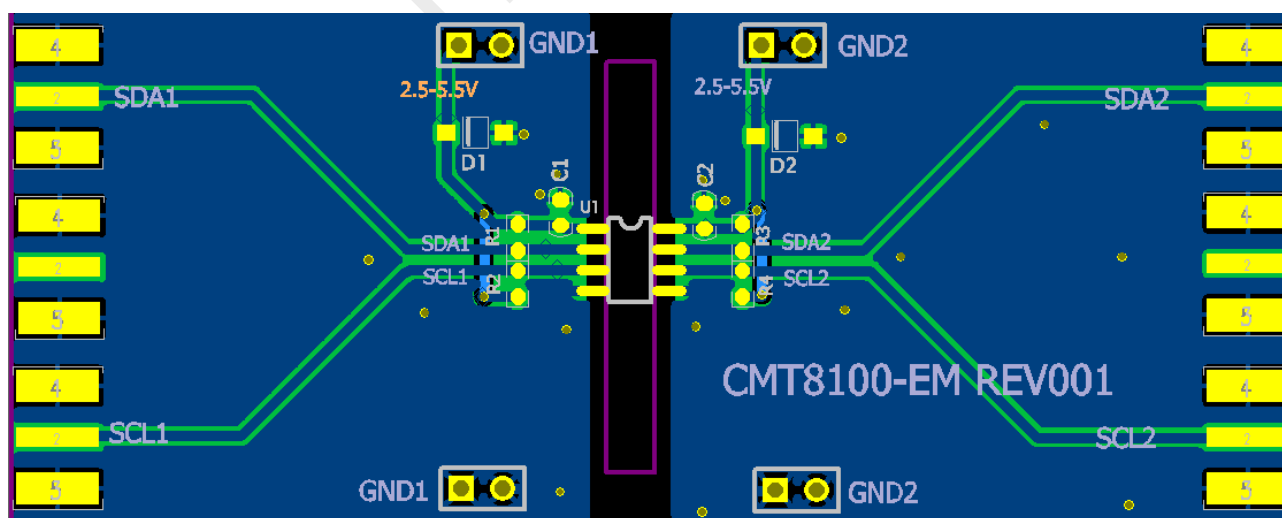


图 5. 推荐 PCB 布局

4 电气特性

VDD1= 2.5 ~5.5V, VDD2=2.5~5.5V, Ta=-40℃ to 125℃。除另行说明外，典型值在以下条件测得：VDD1 = 5V, VDD2 = 5V, Ta = 25℃。

4.1 电气特性

表 4. 电气特性

参数	符号	条件	最小	典型	最大	单位
上电复位 (POR)	VDD _{POR}	上电 (POR) 阈值		2.2		V
	VDD _{HYS}	上电迟滞 (POR) 阈值		0.1		V
POR之后启动时间	trbs			40		usec
瞬态共模抑制	CMTI			±150		kV/us
隔离栅第一侧逻辑电平						
输入阈值	V _{ILT1}	上升沿输入阈值	400			mV
	V _{IHT1}				600	mV
	V _{IT_HYS1}	迟滞输入阈值		100		mV
输出低电平	V _{OL1}	IOL ≤ 4mA, RPULL UP=1K	650		800	mV
输出低电平与输入高电平阈值差值	ΔV _{OIT1}		70			mV
隔离栅第二侧逻辑电平						
输入阈值	V _{ILT2}	上升沿输入阈值		1.6		V
	V _{IT_HYS2}	迟滞输入阈值		0.4		V
输入高电平	V _{IH2}		2.0			V
输入低电平	V _{IL2}				0.8	V
输出低电平	V _{OL}	IOL ≤ 30mA			0.5	V

4.2 电源电流特性 - 5 V 电源

VDD1=5V± 10%, VDD2=5V± 10%, Ta=-40℃to 125℃。除另行说明外，典型值在以下条件测得：VDD1 = 5V, VDD2 = 5V, Ta = 25℃。

表 5. 电源电流特性 - 5 V 电源

参数	符号	条件	最小	典型	单位
CMT8100					
电源电流 V _{IN} = 0 V	I _{DD1} (Q0)			4.89	mA
	I _{DD2} (Q0)			3.99	mA
电源电流 V _{IN} = VDDI	I _{DD1} (Q1)			2.56	mA
	I _{DD2} (Q1)			1.97	mA

参数	符号	条件	最小	典型	单位
电源电流 2MHz 信号输入, CL=15pF	$I_{DD1}(2M)$			3.72	mA
	$I_{DD2}(2M)$			2.64	mA
CMT8101					
电源电流 $V_{IN}=0\text{ V}$	I_{DD1}			4.19	mA
	I_{DD2}			2.94	mA
电源电流 $V_{IN}=V_{DDI}$	I_{DD1}			1.97	mA
	I_{DD2}			1.92	mA
电源电流 2MHz 信号输入, CL=15pF	I_{DD1}			2.63	mA
	I_{DD2}			2.37	mA
时钟速率	DR		0	2	MHz
传播延时	t_{PLH12}	See figure 6, R1=1500Ω, R2= 500Ω,无负载		46.66	ns
	t_{PHL12}	See figure 6, R1=1500Ω, R2= 500Ω,无负载		66.66	ns
	t_{PLH21}	See figure 6, R1=1500Ω, R2= 500Ω,n 无负载		38.34	ns
	t_{PHL21}	See figure .6, R1=1500Ω, R2= 500Ω,无负载		72.34	ns
脉宽失真	PWD_{12}	$ t_{PHL12} - t_{PLH12} $		34	ns
	PWD_{21}	$ t_{PHL21} - t_{PLH21} $		20	ns
下降时间	t_{f1}	CL = 30pF		17.1	ns
	t_{f2}	CL = 300pF		26.2	ns

4.3 电源电流特性 - 3.3 V 电源

$V_{DD1}=3.3\text{ V} \pm 10\%$, $V_{DD2}=5\text{ V} \pm 10\%$, $T_a=-40^{\circ}\text{C}$ to 125°C 。除另行说明外, 典型值在以下条件测得: $V_{DD1}=3.3\text{ V}$, $V_{DD2}=3.3\text{ V}$, $T_a=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 6. 电源电流特性 - 3.3 V 电源

参数	符号	条件	最小	典型	单位
CMT8100					
电源电流 $V_{IN}=0\text{ V}$	$I_{DD1}(Q0)$			4.87	mA
	$I_{DD2}(Q0)$			3.98	mA
电源电流 $V_{IN}=V_{DDI}$	$I_{DD1}(Q1)$			2.53	mA
	$I_{DD2}(Q1)$			1.95	mA
电源电流 2MHz 信号输入, CL=15pF	$I_{DD1}(2M)$			3.51	mA
	$I_{DD2}(2M)$			2.78	mA
CMT8101					
电源电流 $V_{IN}=0\text{ V}$	I_{DD1}			4.17	mA
	I_{DD2}			2.93	mA

参数	符号	条件	最小	典型	单位
电源电流 $V_{IN} = V_{DDI}$	I_{DD1}			1.94	mA
	I_{DD2}			1.89	mA
电源电流 2MHz 信号输入, $CL=15pF$	I_{DD1}			2.73	mA
	I_{DD2}			2.29	mA
时钟速率	DR		0	2	MHz
传播延时	t_{PLH12}	See figure 6, $R1=1500\Omega$, $R2= 500\Omega$, no load		46.66	ns
	t_{PHL12}	See figure 6, $R1=1500\Omega$, $R2= 500\Omega$, no load		66.66	ns
	t_{PLH21}	See figure 6, $R1=1500\Omega$, $R2= 500\Omega$, no load		38.34	ns
	t_{PHL21}	See figure 6, $R1=1500\Omega$, $R2= 500\Omega$, no load		72.34	ns
脉宽失真	PWD_{12}	$ t_{PHL12} - t_{PLH12} $		34	ns
	PWD_{21}	$ t_{PHL21} - t_{PLH21} $		20	ns
下降时间	t_{f1}	$CL = 30pF$		17.1	ns
	t_{f2}	$CL = 300pF$		26.2	ns

4.4 电源电流特性 - 2.5 V 电源

$V_{DD1}=2.5 V \pm 10\%$, $V_{DD2}=2.5 \pm 10\%$, $T_a=-40^{\circ}C$ to $125^{\circ}C$ 。除另行说明外, 典型值在以下条件测得: $V_{DD1} = 3.3 V$, $V_{DD2} = 2.5V$, $T_a = 25^{\circ}C$ 。

表 7. 电源电流特性 - 2.5 V 电源

参数	符号	条件	最小	典型	单位
CMT8100					
电源电流 $V_{IN} = 0 V$	$I_{DD1}(Q0)$			4.85	mA
	$I_{DD2}(Q0)$			3.96	mA
电源电流 $V_{IN} = V_{DDI}$	$I_{DD1}(Q1)$			2.53	mA
	$I_{DD2}(Q1)$			1.94	mA
电源电流 2MHz 信号输入, $CL=15pF$	$I_{DD1}(2M)$			3.43	mA
	$I_{DD2}(2M)$			2.85	mA
CMT8101					
电源电流 $V_{IN} = 0 V$	I_{DD1}			4.15	mA
	I_{DD2}			2.91	mA
电源电流 $V_{IN} = V_{DDI}$	I_{DD1}			1.97	mA
	I_{DD2}			1.91	mA
电源电流 2MHz 信号输入, $CL=15pF$	I_{DD1}			2.8	mA
	I_{DD2}			2.25	mA
时钟速率	DR		0	2	MHz

参数	符号	条件	最小	典型	单位
传播延时	t_{PLH12}	See figure 6, R1=1500Ω, R2= 500Ω,no load		47.5	ns
	t_{PHL12}	See figure 6, R1=1500Ω, R2= 500Ω,no load		89.5	ns
	t_{PLH21}	See figure 6, R1=1500Ω, R2= 500Ω,no load		40.84	ns
	t_{PHL21}	See figure 6, R1=1500Ω, R2= 500Ω,no load		96.64	ns
脉宽失真	PWD_{12}	$ t_{PHL12} - t_{PLH12} $		42	ns
	PWD_{21}	$ t_{PHL21} - t_{PLH21} $		55.8	ns
下降时间	t_{f1}	$C_L = 30pF$		31	ns
	t_{f2}	$C_L = 300pF$		42	ns

4.5 典型特性

4.6 参数测试电路

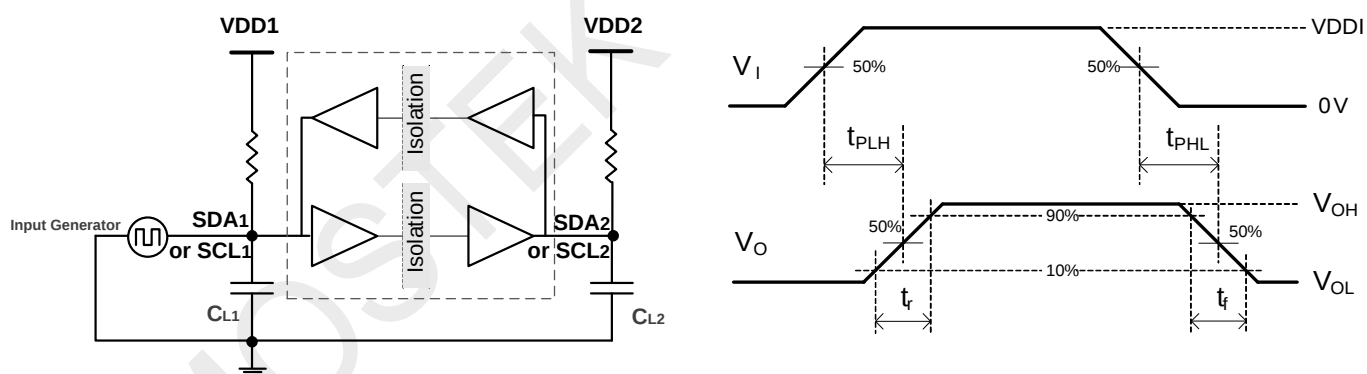


图 6. 开关特性测试电路与电压波形

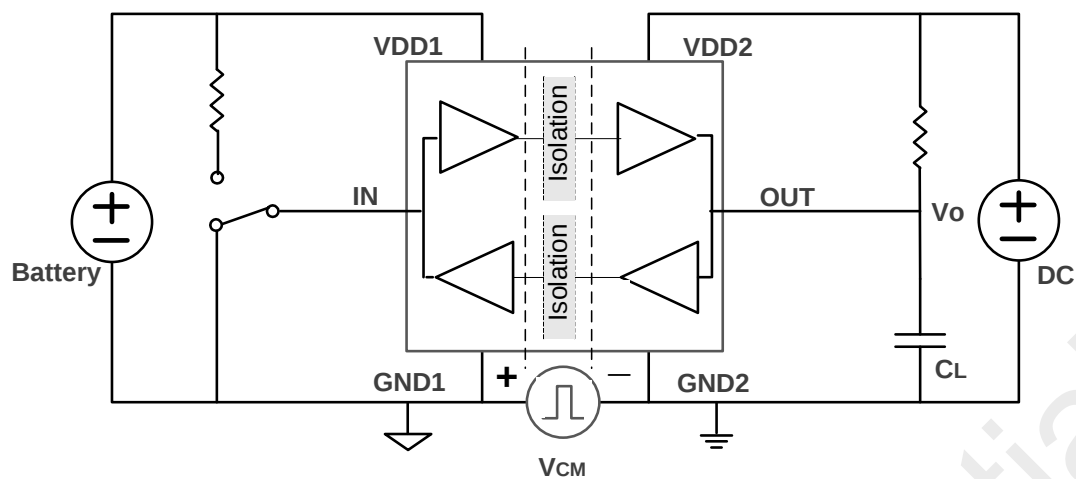


图 7. 瞬态共模抑制能力测试电路

5 高压特性

5.1 隔离特性

表 8.隔离特性

参数	符号	测试条件	值		单位
			SOIC-8	SOIC16-WB	
最小外部间隙	L(I01)	输入端至输出端隔空最短距离	4.0	8.0	mm
最小外部爬电距离	L(I02)	输入端至输出端沿壳体最短距离	4.0	8.0	mm
最小隔离距离	DTI	最小内部间隙	25		um
相对漏电指数	CTI	DIN EN 60112 (VDE 0303-11); IEC 60112	>400		V
材料组			II		

5.2 DIN VDEV 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01 隔离特性

表 9.DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01 隔离特性

参数	符号	测试条件	值		单位
			SOIC-8	SOIC16-WB	
依据 DIN VDE 0110 的安装分类					
额定电源电压 ≤ 150 Vrms			I to IV	I to IV	
额定电源电压 ≤ 300 Vrms			I to III	I to IV	
额定电源电压 ≤ 400 Vrms			I to III	I to IV	
气候分类			10/105/21	10/105/21	
依据 DIN VDE 0110 的污染等级, 表 1			2	2	
最大重复工作绝缘电压 (峰值)	VIORM		565	849	Vpeak
输入到输出测试电压, 方法 B1	V _{pd (m)}	$V_{IORM} \times 1.5 = V_{pd (m)}$, 100%量产测试, $t_{ini} = t_m = 1 \text{ sec}$, 局部放电 < 5 pC。	847	1273	Vpeak
输入到输出测试电压, 方法 A					
环境测试分组 1 之后	V _{pd (m)}	$V_{IORM} \times 1.2 = V_{pd (m)}$, $t_{ini} = 60 \text{ sec}$, $t_m = 10 \text{ sec}$, 局部放电 < 5 pC。	678	1019	Vpeak
输入与安全测试分组 2 和分组 3 之后	V _{pd (m)}	$V_{IORM} \times 1.2 = V_{pd (m)}$, $t_{ini} = 60 \text{ sec}$, $t_m = 10 \text{ sec}$, 局部放电 < 5 pC。	678	1019	Vpeak
最大瞬态耐压	VIOTM	$t = 60 \text{ sec}$	5300	7000	Vpeak

最大浪涌隔离耐压	VIOSM	依据 IEC60065 测试, 1.2/50us 波形, $V_{TEST}=1.3 \times V_{IOSM}$	5300	7000	Vpeak
隔离电阻	RIO	VIO =500V	$>10^9$	$>10^9$	Ω
UL1577					
隔离耐压	VISO	$V_{TEST} = V_{ISO}, t = 60 \text{ s}$ (认证); $V_{TEST} = 1.2 \times V_{ISO}, t = 1 \text{ s}$ (100%量产)	3750	5000	Vrms
隔离电容	CIO	f = 1MHz	0.6	0.6	pF
输入电容	CI		2	2	pF
25℃下功率总损耗	Ps			1499	mW
外壳温度	Ts		150	150	℃

5.3 安规认证

CMT8100N/CMT8101N 符合以下安规认证。

表 10.CMT8100N/CMT8101N 安规认证

CUL		VDE		CQC
UL 1577 器件认证程序认可(申请中)	CSA 组件认证 5A(申请中)	DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-01(申请中)	QC11- 471543-2012 GB4943.1-2011 认证(申请中)	
认证证书或文件编号： pending	认证证书或文件编号： pending	认证证书或文件编号： pending	认证证书或文件编号： pending	
[1]. 依据 UL 1577, 每片 NSi8100N/NSi8101N 施加绝缘测试电压$\geq 4500 \text{ V rms}$ 持续 1 秒, 进行验证测试。 [2]. 依据 DIN VDE V 0884-11, 每片 NSi8100N/NSi8101N 施加绝缘测试电压$\geq 847 \text{ V}$ 峰值持续 1 秒 (局部放电检测极限值 = 5 pC), 进行验证测试。组件上的 * 标记表示 DIN VDE V 0884-11。				

CMT8100W/CMT8101W 符合以下安规认证。

Table 1.CMT8100WCMT8101 Regulation Conformation

CUL		VDE		CQC
UL 1577 器件认证程序认可(申请中)	CSA 组件认证 5A(申请中)	DIN VDE V 0884-11(VDE V 0884-11):2017-012(申请中)	CQC11- 471543-2012 GB4943.1-2011 认证(申请中)	
认证证书或文件编号： pending	认证证书或文件编号： pending	认证证书或文件编号： pending	认证证书或文件编号： pending	

备注:

- [1]. 依据 UL 1577, 每片 NSi8100W/NSi8101W 施加绝缘测试电压 ≥ 6000 V rms 持续 1 秒, 进行验证测试。
- [2]. 依据 DIN VDE V 0884-11, 每片 NSi8100N/NSi8101N 施加绝缘测试电压 ≥ 1273 V 峰值持续 1 秒 (局部放电检测极限值 = 5 pC), 进行验证测试。组件上的 * 标记表示 DIN VDE V 0884-11。

CMOSTEK Confidential

6 功能描述

6.1 功能概述

CMT810x 为基于电容式隔离栅技术的双向隔离器，与 I2C 接口兼容。设备内部 I2C 接口被分成两个单向通道，每个通道通过一个专用的电容隔离通道在相反的方向上进行通信。数字信号由发射端内部振荡器产生的射频载波进行调制，而后通过电容隔离栅传输并在接收器侧解调。

CMT8100 是用于时钟和数据线的高可靠性双通道双向隔离器；CMT8101 为具有双向数据和单向时钟通道的隔离器。CMT8100 适用于多主机应用，而 CMT8101 适用于单主机应用。

CMT810x 的 Side 2 逻辑电平为标准 I2C 值，两侧最大负载 ≤ 400 pF。因此，通过 Side 2 引脚连接到总线的多个 CMT810x 设备可以相互通信，也可与其他 I2C 兼容设备进行通信。

CMT810x 的 Side 1 逻辑电平不是 I2C 标准值。CMT810x 的输出低电平为 650 mV，而低电平输出电压到高电平输入电压的阈值为 50 mV，这样可以防止 Side 1 的输出逻辑低电平被传输回 Side 2 并拉低 I2C 总线。

CMT810x 设备符合 UL1577 安规认证，支持多种绝缘耐压值（3.75 kVrms、5 kVrms），同时以低功耗提供高电磁抗扰度和低辐射。CMT810x 的 I2C 时钟高达 2 MHz，共模瞬态抗干扰度(CMTI) 高达 150 kV/us。CMT810x 器件的宽电源电压支持直接连接大多数数字接口，平稳实现电平转换。其高系统级 EMC 性能增强了设备的可靠性和稳定性。

下表为 CMT810x 的功能状态。当 VDDIN 为 unready 状态且 VDDOUT 为 ready 状态时，CMT810x 为高阻态输出，如下表所示。

表 11.功能模式表

输入	VDD1 状态	VDD2 状态	输出	描述
H	就绪	就绪	Z	正常工作状态
L	就绪	就绪	L	
X	未就绪	就绪	Z	输入侧 VDD1 上电后 60us 内，输出状态在跟随至对应的输入状态。
X	就绪	未就绪	X	输入侧 VDD2 上电后 60us 内，输出状态在跟随至对应的输入状态。

7 封装外形

CMT810x 封装信息如下图所示。

7.1 CMT8100N/CMT8101N SOIC-8 窄体封装

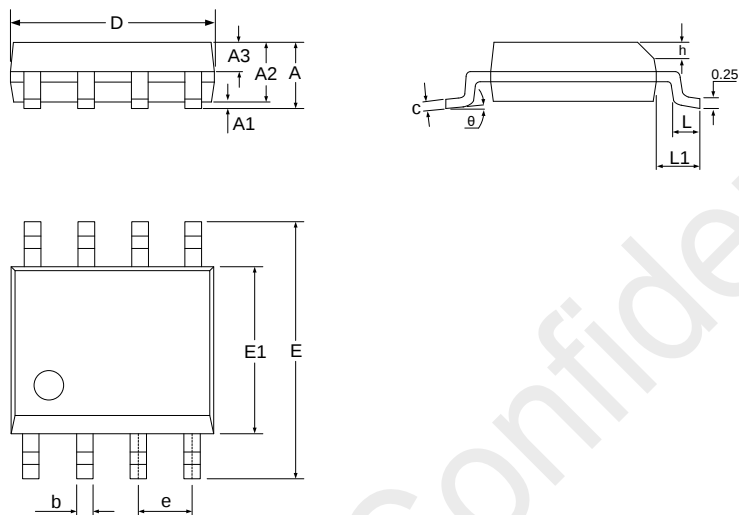


图 8. 窄体 SOIC-8 封装

表 12.SOIC-8 窄体封装尺寸

符号	尺寸 (毫米 mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	1.35	1.55	1.75
A1	0.10	0.18	0.25
A2	1.30	1.40	1.50
b	0.30	0.42	0.51
c	0.17	0.21	0.25
D	4.80	5.00	5.20
E1	3.90	4.00	4.10
E	5.80	6.10	6.20
e	1.27 BSC		
L	0.40	0.60	0.80
θ	0	-	8°

7.2 CMT8100W/CMT8101W 宽体 SOIC-16 封装

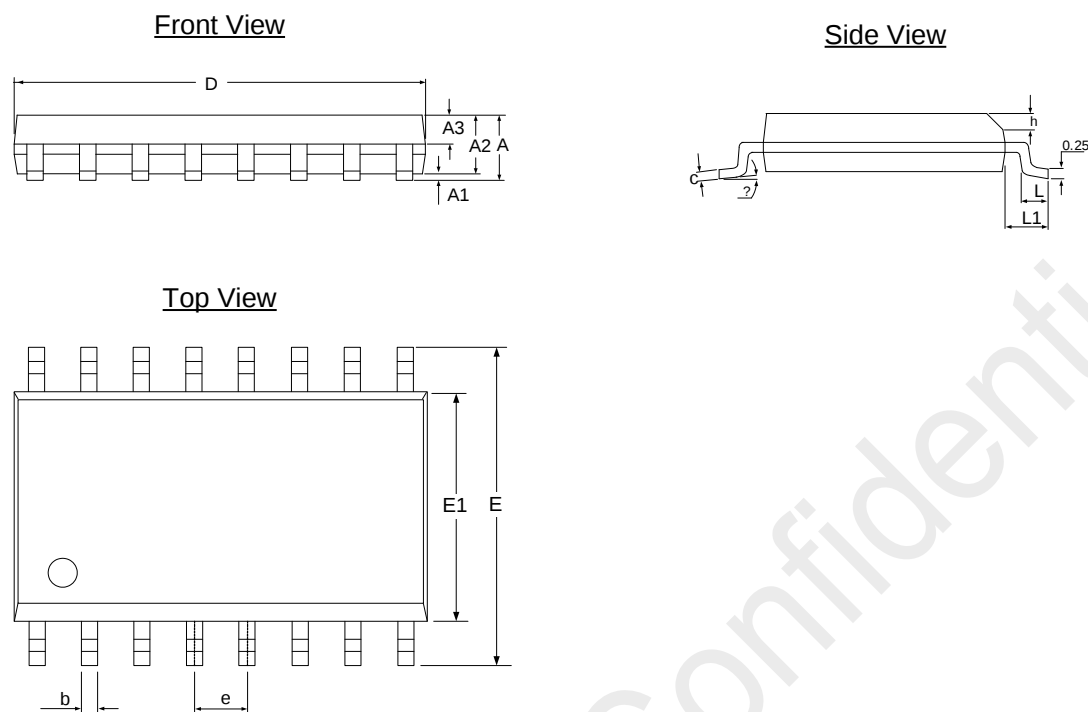


图 9. SOIC-16 宽体封装

表 13. SOIC-16 宽体封装尺寸

符号	尺寸 (毫米 mm)		
	最小值	典型值	最大值
A	-	-	2.65
A1	0.10	0.20	0.30
A2	2.25	2.30	2.35
A3	1.00	1.05	1.10
b	0.35	0.37	0.43
c	0.15	0.20	0.30
D	10.30	10.40	10.50
E	10.10	10.30	10.50
E1	7.40	7.50	7.60
e	1.14	1.27	1.40
L	0.65	0.70	0.85
L1	1.40		
θ	0	-	8°

8 顶部丝印



图 10. CMT810x 顶部丝印

表 14.CMT810x 顶部丝印说明

丝印方式:	激光
管脚 1 标记:	圆圈直径 = 1 mm
字体大小	0.5 mm, 右对齐
第一行丝印:	P = 0 / 1 , 分别代表芯片型号 CMT8100x / CMT8101x。 NNN 代表产品命名规则中 CMT810P 的后续字符, 其具体含义详见第 11 章节产品命名规则。
第二行丝印:	YYWW 是封装日期编号。其中, YY 代表年份的最后 2 位数, WW 代表工作周; ①②③④⑤⑥是产品追踪号。

9 订购信息

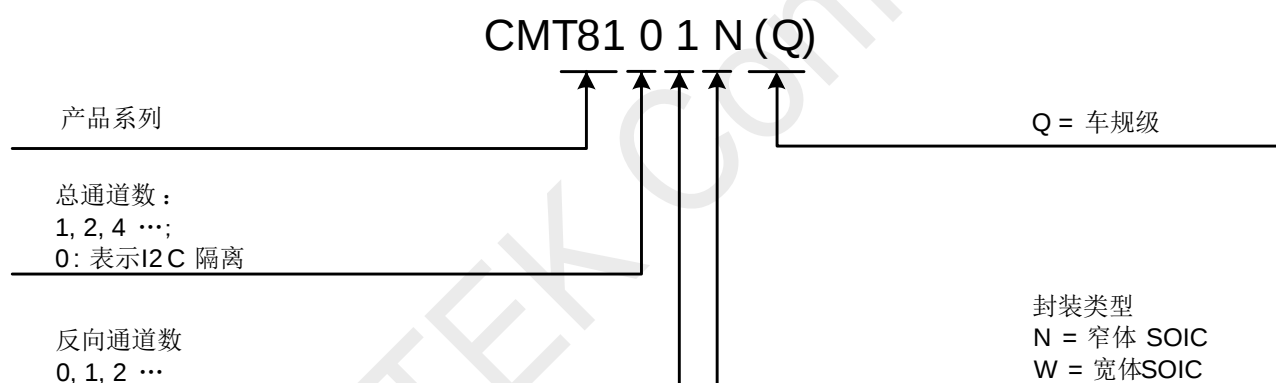
表 15.产品订购列表

产品型号	隔离耐压 (kV)	隔离第一侧输入通道数	隔离第一侧输入通道数	最大速率 (MHz)	温度	是否车规	封装
CMT8100N	3.75	2	2	2	-40 to 125℃	NO	SOIC8
CMT8101N	3.75	2	1	2	-40 to 125℃	NO	SOIC8
CMT8100W	5	2	2	2	-40 to 125℃	NO	WB SOIC16
CMT8101W	5	2	1	2	-40 to 125℃	NO	WB SOIC16

备注:

- 根据 JEDEC 行业标准分类和峰值焊接温度, 所有封装均符合 RoHS 标准, 峰值回流温度为 260 ° C。
- 所有设备均符合 AEC-Q100 标准。

产品命名规则:



如需了解更多产品及产品线信息, 请访问 www.cmostek.com。

有关采购或价格需求, 请联系 sales@cmotek.com 或者当地销售代表。

10 文档变更记录

表 16.文档变更记录

版本号	章节	变更描述	日期
0.1	所有	初始版本	2021/11/02
0.2	4	修改电源电流特性数据	2022/08/30

11 联系方式

无锡泽太微电子有限公司深圳分公司

深圳市南山区西丽街道万科云城 3 期 8 栋 A 座 30 楼

邮编: 518055

电话: +86-755-83231427

销售: sales@cmostek.com

技术支持: support@cmostek.com

网址: www.cmostek.com